
СОДЕРЖАНИЕ

Том 49, номер 5, 2020

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование резистивного переключения в мемристорных структурах на основе оксидов переходных металлов

О. О. Пермякова, А. Е. Рогожин

323

Ab initio моделирование электронной и энергетической структуры, а также открытие ширины запрещенной зоны легированного 4p-элементами монослоя графена

М. М. Асадов, С. С. Гусейнова, В. Ф. Лукичев

334

Моделирование характеристик КНИ КМОП нанотранзисторов с асимметричным полностью охватывающим затвором

Н. В. Масальский

344

Моделирование переходных процессов в мажоритарном элементе при переключении и сборе заряда с трека одиночной частицы

В. Я. Стенин, Ю. В. Катунин

353

МАТЕРИАЛЫ

Исследование динамики релаксационной поляризации твердого электролита LiPON

*А. С. Рудый, М. Е. Лебедев, А. А. Мироненко, Л. А. Мазалецкий,
В. В. Наумов, А. В. Новожилова, И. С. Федоров, А. Б. Чурилов*

366

Исследование магнитооптических свойств структур на искривленных поверхностях для разработки элементов памяти на магнитных вихрях

А. В. Проказников, В. А. Папорков

380

ПРИБОРЫ

Механизм транспорта заряда в бесформовочном мемристоре на основе нитрида кремния

О. М. Орлов, А. А. Гисматулин, В. А. Гриценко, Д. С. Мизгинов

395
